

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Якимов Евгений Борисович
2	Дата рождения (полная)	17 ноября 1947 г.
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук, специальность – 01.04.10
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Институтская, д. 6 http://www.iptm.ru eagle@iptm.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук
	Ведомственная принадлежность организации	РАН
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	Лаборатория локальной диагностики полупроводниковых материалов
	Должность	Заведующий лабораторией
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alexander Y. Polyakov, Vladimir I. Nikolaev, Eugene B. Yakimov, Fan Ren, Stephen J. Pearton and Jihyun Kim, “Deep level defect states in β-, α-, and ε-Ga₂O₃ crystals and films: Impact on device performance”, JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A, 40, 020804 (2022). 2. Eugene B. Yakimov, Alexander Y. Polyakov, and Stephen J. Pearton, “Betavoltaic cell based on Ni/β-Ga₂O₃ and ⁶³Ni source”, JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A, 40, 010401 (2022). 3. A. Y. Polyakov, I. V. Shchemerov, A. A. Vasilev, A. I. Kochkova, N. B. Smirnov, A. V. Chernykh, E. B. Yakimov, P. B. Lagov, Yu. S. Pavlov, E. M. Ivanov, O. G. Gorbatkova, A. S. Drenin, M. E. Letovaltseva, Minghan Xian, Fan Ren, Jihyun Kim, and S. J. Pearton, “1 GeV proton damage in β-Ga₂O₃”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 130, 185701 (2021). 4. E. B. Yakimov, A. Y. Polyakov, I. V. Shchemerov, N. B. Smirnov, A. A. Vasilev, P. S. Vergeles, E. E. Yakimov, A. V. Chernykh, F. Ren, and S. J. Pearton, “Experimental estimation of electron–hole pair creation energy in β-Ga₂O₃”, APPL. PHYS. LETT., 118, 202106 (2021). 5. Alexander Y. Polyakov, Vladimir I. Nikolaev, Sergey A. Tarelkin, Alexei I. Pechnikov, Sergey I. Stepanov, Andrey E. Nikolaev, Ivan V. Shchemerov, Eugene B. Yakimov, Nikolay V. Luparev, Mikhail S. Kuznetsov, Anton A. Vasilev, Anastasiya I. Kochkova, Marina I. Voronova, Mikhail P. Scheglov, Jihyun Kim, and Stephen J. Pearton, 	

	<p>“Electrical properties and deep trap spectra in Ga₂O₃ films grown by halide vapor phase epitaxy on p-type diamond substrates”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 129, 185701 (2021).</p> <p>6. P. S. Vergeles, E. B. Yakimov, A. Y. Polyakov, I. V. Shchemerov, A. V. Chernykh, A. A. Vasilev, A. I. Kochkova, In-Hwan Lee and Stephen J. Pearton, “Parasitic p–n junctions formed at V-pit defects in p-GaN”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 129, 155702 (2021).</p> <p>7. O. V. Feklisova, E. E. Yakimov and E. B. Yakimov, “Study of single-layer stacking faults in 4H–SiC by deep level transient spectroscopy”, APPL. PHYS. LETT., 116, 172101 (2020).</p> <p>8. A. Y. Polyakov, In-Hwan Lee, N. B. Smirnov, E. B. Yakimov, I. V. Shchemerov, A. V. Chernykh, A. I. Kochkova, A. A. Vasilev, F. Ren, P. H. Carey IV and S. J. Pearton, “Hydrogen plasma treatment of β-Ga₂O₃: Changes in electrical properties and deep trap spectra”, APPL. PHYS. LETT., 115, 032101 (2019).</p> <p>9. Eugene B. Yakimov, Alexander Y. Polyakov, In-Hwan Lee, and Stephen J. Pearton, “Recombination properties of dislocations in GaN”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 123, 161543 (2018).</p>	
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)	
9	Адрес электронной почты	